1.Излучающие полупроводниковые приборы. Устройство, принцип действия, характеристики и параметры.

2.Изобразите принципиальную схему базового элемента 2И-НЕ на МДП
транзисторах с индуцированным калом n-типа. Составьте таблицу истинности.
Приведите вид передаточной характеристики. Объясните, какие параметры ЦИМС можно определить с использованием передаточной характеристики.

3.Изобразите принципиальную схему усилительного каскада на МДП ПТ с
встроенным каналом p-типа.

Приведите передаточную и выходные характеристики транзисторов и покажите, как определяют Y-параметры необходимые для расчета коэффициентов усиления по току, напряжению и по мощности.

Поясните, как строится нагрузочная прямая и выбирается положение рабочей точки.